

# 2SJ113

查詢 2SJ113 代理商

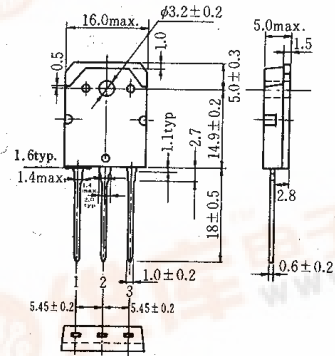
捷多邦, 专业PCB打样工厂, 24小时加急出货

## シリコン P チャンネル MOS FET

高速度電力スイッチング用  
2SK399 とコンプリメンタリペア

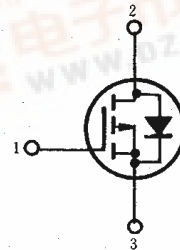
## SILICON P-CHANNEL MOS FET

HIGH SPEED POWER SWITCHING  
Complementary pair with 2SK399



(TO-3P)

1. ゲート: Gate
2. ドレイン: Drain  
(フランジ) (Flange)
3. ソース: Source  
(Dimensions in mm)



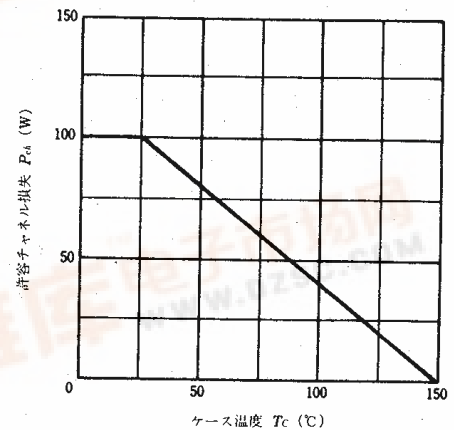
### ■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	2SJ113	Unit
ドレイン・ソース電圧	$V_{DSS}$	-100	V
ゲート・ソース電圧	$V_{GSS}$	±20	V
ドレイン電流	$I_D$	-10	A
せん頭ドレイン電流	$I_{D(peak)}$	-15	A
逆ドレイン電流	$I_{DR}$	-10	A
許容チャンネル損失	$P_{cA}^*$	100	W
チャンネル温度	$T_{cA}$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55~+150	$^\circ\text{C}$

\*  $T_c=25^\circ\text{C}$  における許容値

\* Value at  $T_c=25^\circ\text{C}$

### 許容チャンネル損失のケース温度による変化 MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION CURVE



### ■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン・ソース破壊電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D=-10\text{mA}, V_{GS}=0$	-100	-	-	V
ゲート遮断電流	$I_{GSS}$	$V_{GS}=\pm 20\text{V}, V_{DS}=0$	-	-	±1	$\mu\text{A}$
ドレイン電流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=-80\text{V}, V_{GS}=0$	-	-	-1	mA
ゲート・ソース遮断電圧	$V_{GS(off)}$	$I_D=-1\text{mA}, V_{DS}=-10\text{V}$	-2.0	-	-5.0	V
ドレイン・ソースオン抵抗	$R_{DS(on)}$	$I_D=-5\text{A}, V_{GS}=-15\text{V}^*$	-	0.25	0.35	$\Omega$
ドレイン・ソース飽和電圧	$V_{DS(on)}$	$I_D=-5\text{A}, V_{GS}=-15\text{V}^*$	-	-1.25	-1.75	V
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$I_D=-5\text{A}, V_{DS}=-10\text{V}^*$	1.5	2.0	-	S
入力容量	$C_{iss}$	$V_{DS}=-10\text{V}, V_{GS}=0$ $f=1\text{MHz}$	-	1100	-	pF
出力容量	$C_{oss}$		-	650	-	pF
逆伝達容量	$C_{rss}$		-	90	-	pF
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$	$I_D=-2\text{A},$ $V_{GS}=-15\text{V},$ $R_L=15\Omega$	-	20	-	ns
立ち上がり時間	$t_r$		-	50	-	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		-	90	-	ns
下降時間	$t_f$		-	70	-	ns
入力順電圧	$V_{DF}$	$I_F=-5\text{A}, V_{GS}=0$	-	-0.9	-	V
逆回復時間	$t_{rr}$	$I_F=-5\text{A}, V_{GS}=0, di_F/dt=50\text{A}/\mu\text{s}$	-	250	-	ns

\* パルス測定  
\* Pulse Test